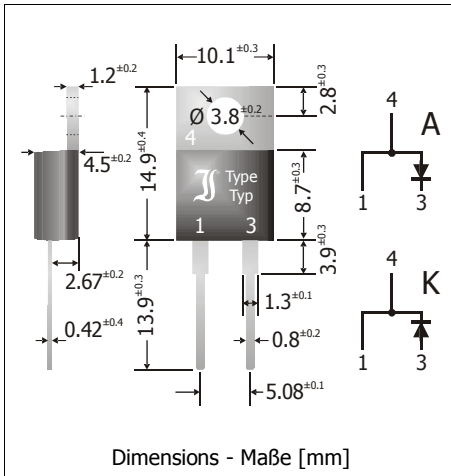


**FT2000AA ... FT2000KG**

**Superfast Silicon Rectifiers – Single Diode / Two Polarities  
Superschnelle Silizium-Gleichrichter – Einzeldiode / Zwei Polaritäten**

Version 2010-03-31



- Nominal current / Nennstrom: 20 A
- Repetitive peak reverse voltage / Periodische Spitzensperrspannung: 50...400 V
- Plastic case / Kunststoffgehäuse: TO-220AC
- Weight approx. / Gewicht ca.: 1.8 g
- Plastic material has UL classification 94V-0 / Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
- Standard packaging in tubes / Standard Lieferform in Stangen



**Maximum ratings and Characteristics**

**Grenz- und Kennwerte**

Type / Typ	Repet. peak reverse voltage / Period. Spitzensperrspanng.	Surge peak reverse volt. / Stoßspitzensperrspanng.	Forward voltage / Durchlass-Spannung	
Polarity / Polarität	$V_{RRM}$ [V]	$V_{RSM}$ [V]	$V_F$ [V] <sup>1)</sup>	
K (Standard)	A (Reverse)		$I_F = 5 A$	$I_F = 20 A$
FT2000KA	FT2000AA	50	< 0.84	< 0.96
FT2000KB	FT2000AB	100	< 0.84	< 0.96
FT2000KD	FT2000AD	200	< 0.84	< 0.96
FT2000KG	FT2000AG	400	< 0.84	< 0.96

Max. average forward rectified current, R-load / Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ C$	$I_{FAV}$	20 A
Repetitive peak forward current / Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 Hz$	$I_{FRM}$	80 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave / Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ C$	$I_{FSM}$	375/390 A
Rating for fusing, $t < 10 ms$ / Grenzlastintegral, $t < 10 ms$	$T_A = 25^\circ C$	$i^2t$	680 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		$T_j$	-50...+150°C
		$T_j$	+200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	-50...+175°C

1  $T_j = 25^\circ C$

2 Max. temperature of the case  $T_C = 100^\circ C$  – Max. Temperatur des Gehäuses  $T_C = 100^\circ C$

**Characteristics**
**Kennwerte**

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 25 $\mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 0.5 \text{ A}$ through/über $I_R = 1 \text{ A}$ to $I_R = 0.25 \text{ A}$	$t_{rr}$	< 200 ns
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		$R_{thc}$	< 1.5 K/W

